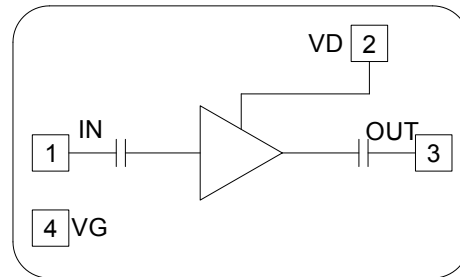


特点:

- 频率: 24~40GHz
- 高增益: 22dB
- 低噪声: 2dB
- 输出-1dB 压缩点: 11dBm
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 2.1×1.37×0.1mm

功能框图



性能参数: (TA=+25℃, VD=+5V, ID=66mA)

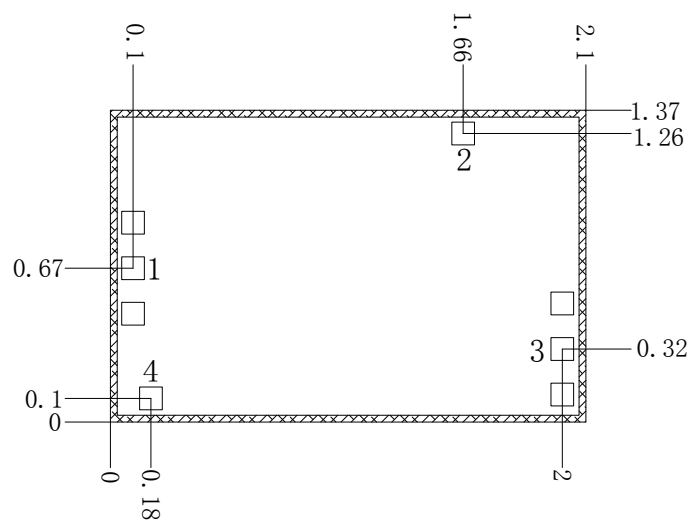
参数名称	符号	测试条件	参数值									单位	备注
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+5.0V Zin=Zout=50Ω	24~27			27~37			37~40			GHz	
增益	G		22	24		18	20		15	17		dB	
输入驻波	VSWRi			2			2			2			
输出驻波	VSWRo			1.6			1.6			1.6			
噪声系数	NF			2.2	2.7		2.0	2.5		2.2	2.7	dB	
输出 P ₋₁	P ₋₁		9	11		9	11		9	11		dBm	
电压	VD		4.75~5.25									V	
电流	ID	VD=+5.0V		66			66			66		mA	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+5.5	V	最大输入功率 (24~32GHz)	+5	dBm
贮存温度	-55~+150	℃	最大输入功率 (32~40GHz)	-1	dBm

芯片尺寸图:

单位: mm

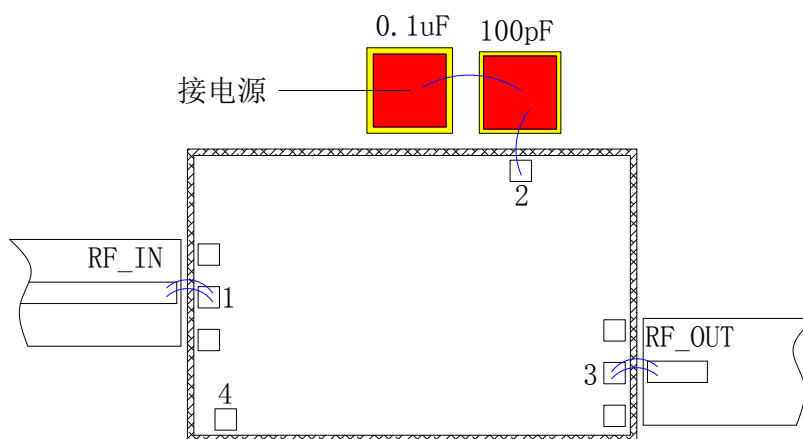


注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

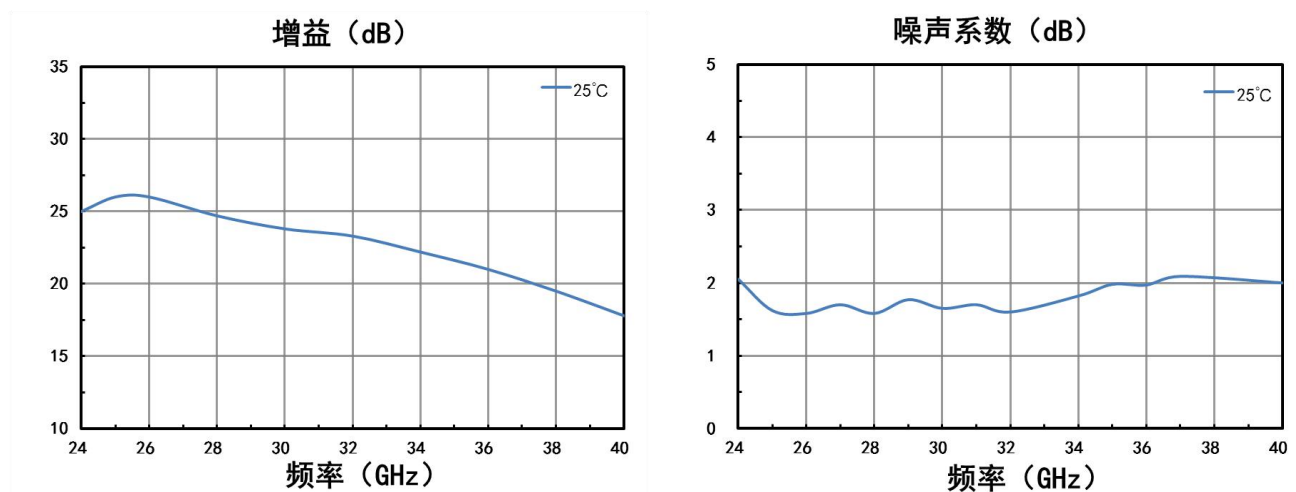
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入，AC 耦合
2	VD	放大器电源电压，需外接 100pF 和 0.1uF 旁路电容
3	OUT	射频输出，AC 耦合
4	VG	可选焊盘，用于覆盖默认偏置条件
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

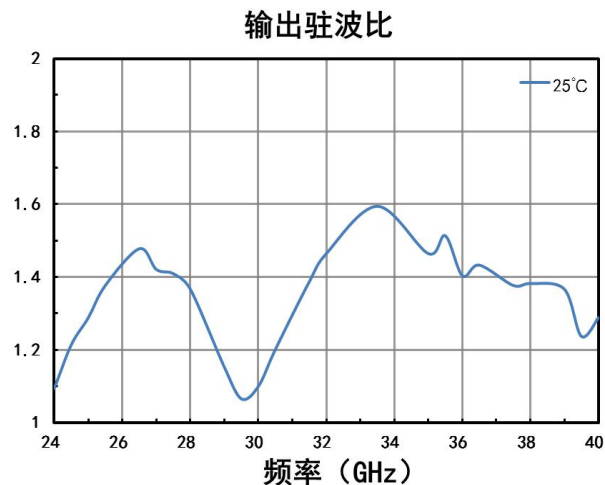
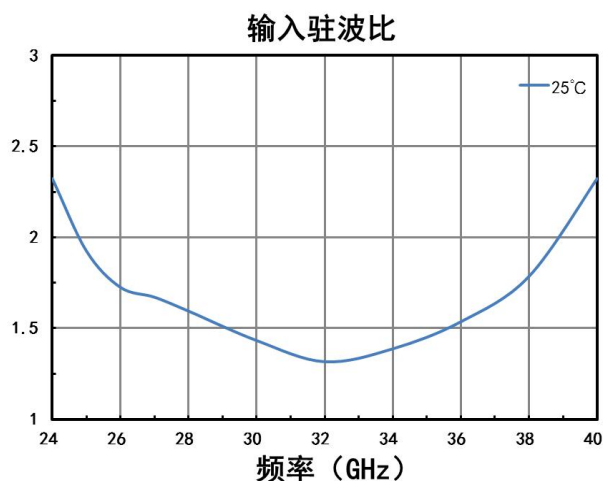
推荐装配图：



注：未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：





产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。